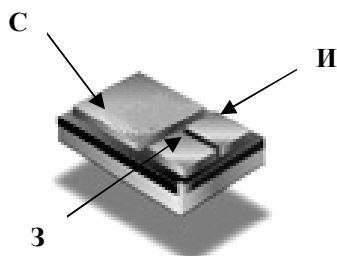


2П797Г, Г91, Г93

ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЙ N-КАНАЛЬНЫЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ И N-КАНАЛОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ, ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ АППАРАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.



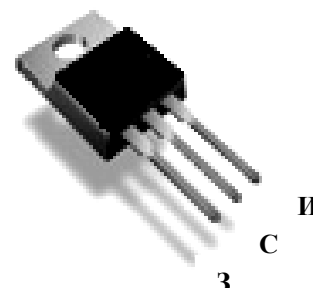
SMD2

* Зарубежный аналог - **IRF540**
Изготавливается в корпусах:

2П797Г- КТ-28-2

2П797Г91- D²РАК

2П797Г93- SMD2



**КТ-28-2 (D²РАК цоколевка
аналогичная)**

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Предельные значения
Макс. допустимое напряжение сток-исток	U _{си макс}	В	100
Макс. допустимое напряжение затвор-исток	U _{зи макс}	В	± 20
Макс. допустимый пост. ток стока при T _{корп} ≤ 20°C при T _{корп} =	I _{с макс}	А	28 23
100°C			
Макс. допустимый импульсный ток стока	I _{с и макс}	А	110
Макс. допустимый постоянный прямой ток диода	I _{пр макс}	А	28
Макс. допустимый импульсный прямой ток диода	I _{пр и макс}	А	110
Макс. допустимая энергия одиночного импульса, рассеиваемая транзистором в режиме лавинного пробоя (T _{п нач.} = 25°C, U _{си} = 25 В, R _г = 25 Ом, I _с = 28А, L = 316 мкГн)	E _{АС}	Дж	0.23
Макс. допустимая постоянная рассеиваемая мощность (T _{корп.} ≤ 25°C)	P макс	Вт	150
Тепловое сопротивление переход-корпус (в КТ-28-2)	R _{t п- корп}	°С/ Вт	1.0
Тепловое сопротивление переход-среда	R _{t п- ср}	°С/ Вт	62

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (T_{окр. ср.} = 25°C)

Наименование электрического параметра, единица измерения	Обозначение	Режимы измерения	Нормы	
			Не менее	Не более
Пороговое напряжение, В	U _{зи пор}	I _с = 0,25мА, U _{зи} = U _{си}	2,0	4,0
Ток стока, А	I _с	U _{си} = 2,8 В, U _{зи} = 0В t _и ≤ 300мкс, Q ≥ 50	28	-
Сопrotивление сток-исток в открытом состоянии, Ом	R _{си отк.}	I _с = 17А, U _{зи} = 10В t _и ≤ 300мкс, Q ≥ 50	-	0,077
Остаточный ток стока, мкА	I _{с ост.}	U _{си} = 100 В, U _{зи} = 0	-	25
Ток утечки затвора, нА	I _{з ут.}	U _{си} = 0, U _{зи} = ±20 В	-	100
Крутизна, А/В	S	U _{си} = 25 В, I _с = 17 А t _и ≤ 300мкс, Q ≥ 50	8,7	-
Постоянное прямое напряжение диода, В	U _{пр}	I _с = -28А, U _{зи} = 0В t _и ≤ 300мкс, Q ≥ 50	-	2.5

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>